

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. 7
G02F 1/136

(11)
(43)

2002 - 0056724
2002 07 10

(21) 10 - 2000 - 0086129
(22) 2000 12 29

(71) 136 - 1

(72) 179 - 4 201

(74)
:

(54)

tal Display) (Module) LCD (moulding) 가
 , BM (BlackMatrix), ITO , LCD(Liquid Crys
 BM 30nm , C/F TFT C/F ITO
 SiO2 가 .

4

1 LCD .

2 1 .
 3 TFT LCD .
 4 LCD .
 5 4 .
 < >
 10 : TFT 20 :
 22 : (BlackMatrix:BM)
 24 : ITO(Indium Tin Oxide) 30 : (SiO2)
 50 : (silicon)

LCD LCD (moulding) 가 ,
 LCD , LCD , LCD TV .

1 LCD , 2 1 ,
 3 TFT LCD , (2) (4)가 가
 LCD , (6) (8) (Color Fil
 ter: C/F) (9) (b) (8) , 2 ,
 (Color Filter: C/F)(20) TFT (10) (Black Matrix
 : BM)(8) 3 (BackLight: B/L) , C/F
 a (12) .

C/F (9) BM(8) 0.3mm (20) TFT
 (10) (seal)(12) (Cr) BM(8) 0.3mm
 3 (moulding) 가
 , , 가 (gap) . (silicon)
 가

가 가 BM LCD 가

가

LCD

(ColorFilter) ITO , BM 30nm , C/F TFT , BM(BlackMatrix), ITO C/F

SiO2

SiO2 100 ° C RF C/F

BM 2 CrOx/Cr, 3 CrOx/CrNx/Cr

BM

SiNx SiON

LCD

4 LCD , 5 4

SiO2 (30) ITO(24) C/F BM

(barrier) SiO2 (seal) 가 SiO2 (30) 30nm (6)

ensing) SiO2 TR(transfer) (disp

SiO2 (30) 100 ° C RF C/F

3

LCD -

가

SiO2 LCD , C/F

가

, , 가 가 , ,

(57)

1.

BM(BlackMatrix), ITO C/F(ColorFilter) ITO BM 30nm ,
 C/F TFT

2.

1 , SiO2

3.

2 , SiO2 100 ° C RF C/F

4.

1 , BM 2 CrOx/Cr, 3 CrOx/CrNx/Cr

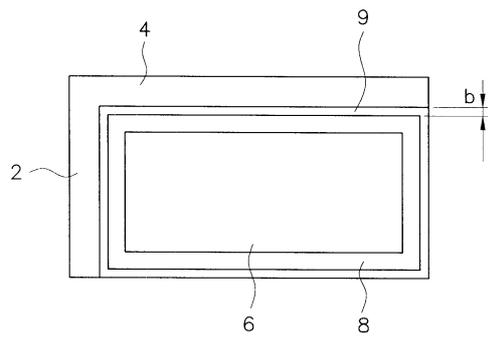
5.

1 , BM

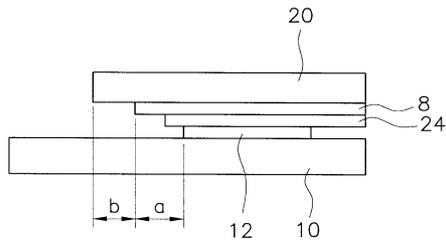
6.

1 , SiNx SiON

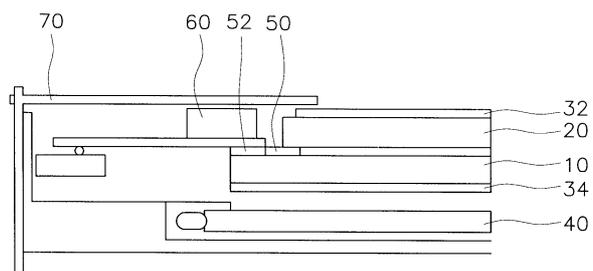
1



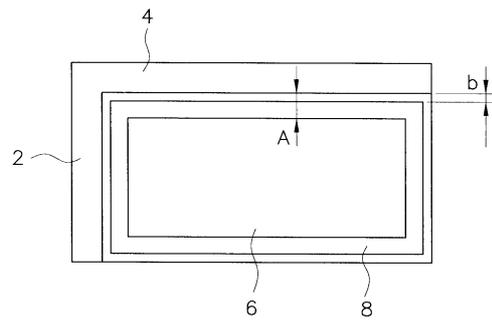
2



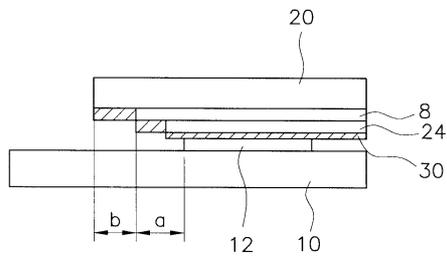
3



4



5



专利名称(译)	如何制作具有高湿度的LCD模块		
公开(公告)号	KR1020020056724A	公开(公告)日	2002-07-10
申请号	KR1020000086129	申请日	2000-12-29
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	PARK JANGSICK 박장식		
发明人	박장식		
IPC分类号	G02F1/136		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

LCD (液晶显示器) 模块制造方法本发明涉及具有强防湿性能的LCD (液晶显示器) 模块制造方法, 作为具有强防湿性能的LCD模块制造方法, 其可以保护其覆盖暴露于外部的黑色矩阵。防止光源和它选择用于成型 (成型) 的垫和湿气扩散垫部分并具有在BM (BlackMatrix) 上形成的状态和ITO膜是C / F (ColorFilter) 玻璃相的效果, 除了BM的暴露部分的下侧的有效区域和称为焊盘间隔和面板的滤色器之外, 30nm的镀层在ITO膜上沉积防潮层。关于水分的反作用力增强, 因为通过用硅树脂模制的垫部分可以增强对湿气的反作用力并使C / F基板和TFT基板之间的密封, 并且SiO₂沉积在铬的上部根据高温高湿度或长期使用的可靠性试验, 可以消除有效区域外角C / F的黑矩阵和铬黑矩阵区域的损坏。

